

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr. | UNINA990007700090403321 |
| Autore | Martin, James <1933- > |
| Titolo | The Computerized Society / Martin, James , Norman, Adrian R. D. |
| Pubbl/distr/stampa | London : Prentice-Hall, 1970 |
| Descrizione fisica | 560 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 346.01 |
| Locazione | DDCP |
| Collocazione | 19-E-129 |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| 2. Record Nr. | UNINA9910809279803321 |
| Autore | Zhytnytska Rimma |
| Titolo | Design von GaN Transistoren fur leistungselektronische Anwendungen
// Rimma Zhytnytska |
| Pubbl/distr/stampa | Gottingen : , : Cuvillier Verlag, , [2021]
©2021 |
| ISBN | 3-7369-6413-7 |
| Edizione | [1st ed.] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (183 pages) |
| Collana | Innovationen mit Mikrowellen und Licht. Forschungsberichte aus dem
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fur Hochstfrequenztechnik ; ;
65 |
| Disciplina | 548.5 |
| Soggetti | Epitaxy |
| Lingua di pubblicazione | Tedesco |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Nota di contenuto | Intro -- 1 Kapitel: Einfuhrung -- 1.1 Motivation -- 1.2 Ziel und Aufbau
der Arbeit -- 2 Kapitel: Grundlagen der AlGaIn/GaN-HEMTs -- 2.1
Materialeigenschaften von GaN und AlGaIn/GaN Heterostruktur -- 2.2 |

AlGaN/GaN HEMT: Aufbau, Funktion und typische Kennlinien -- 3
Kapitel: Designkonzept für LE-Transistoren -- 3.1 Grundlagen des
Designs -- 3.2 Anforderungen an GaN-Transistoren für die
Leistungselektronikanwendungen -- 3.3 Designkonzept der GaN-
Transistoren für Leistungselektronikanwendungen -- 4 Kapitel:
Prozessdetails und Messmethoden -- 4.1 Herstellung der Transistoren
und Teststrukturen -- 4.2 Elektrische Charakterisierung -- 5 Kapitel:
Design für hohe Spannung -- 5.1 AlGaN/GaN HEMT im gesperrten
Zustand -- 5.2 Designoptimierung für hohe Durchbruchfestigkeit --
5.3 Zusammenfassung des Kapitels 5 -- 6 Kapitel: Design für niedrigen
 R_{on} und hohe Stromtragfähigkeit -- 6.1 Thermische Effekte im
AlGaN/GaN HEMT -- 6.2 Elektrisch-thermische Charakterisierung des
Al- GaN/GaN HEMTs -- 6.3 Designstudie (ANSYS) -- 6.4
Zusammenfassung des Kapitels 6 -- 7 Kapitel: LE-Transistoren -
Design und Charakterisierung -- 7.1 Optimiertes Transistordesign --
7.2 Charakterisierung der LE-Transistoren -- 7.3 Zusammenfassung
des Kapitels 7 -- 8 Kapitel: Zusammenfassung und Ausblick -- 8.1
Zusammenfassung und Fazit -- 8.2 Ausblick -- Quellenverweis --
Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis.
